








	<h2>SI7431DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7431DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7431DP-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 802189 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7431DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	802189 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 2.2A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	174 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7431DP-T1-GE3-ND

SI7431DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7431DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7431DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7431DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7430DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7431DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7431DP</b> Vishay Precision Group SI7431DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7431DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7434DP</b> SI SI7434DP SI</p>	 <p><b>SI7434DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.3A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7434ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 250V POWERPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7431DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

SI7415DN	SI7415DN-T1-E3	SI7415DN-T1-E3	SI7415DN-T1-GE3	SI7415DN-T1-GE3
SI7421DN	SI7421DN-T1-E3	SI7421DN-T1-E3	SI7421DN-T1-GE3	SI7421DN-T1-GE3
SI7423DN	SI7423DN-T1-E3	SI7423DN-T1-E3	SI7423DN-T1-GE3	SI7423DN-T1-GE3
SI7425DN-T1-E3	SI7425DN-T1-E3	SI7430DP-T1-E3	SI7430DP-T1-E3	SI7430DP-T1-GE3
SI7430DP-T1-GE3	SI7431DP	SI7431DP-T1-E3	SI7431DP-T1-E3	SI7431DP-T1-GE3
SI7434DP	SI7434DP-T1-E3	SI7434DP-T1-E3	SI7434DP-T1-GE3	SI7434DP-T1-GE3
SI7439DP-T1-E3	SI7439DP-T1-E3	SI7439DP-T1-GE3	SI7439DP-T1-GE3	SI7440DP
SI7440DP-T1	SI7440DP-T1-E3	SI7440DP-T1-E3	SI7440DP-T1-GE3	SI7440DP-T1-GE3
SI7442DP-T1	SI7442DP-T1-E3	SI7444DP-T1-GE3	SI7445DP-T1	SI7445DP-T1-E3
SI7445DP-T1-E3	SI7445DP-T1-GE3	SI7445DP-T1-GE3	SI7446BDP	SI7446BDP-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited